



# 陕西省半导体行业 简讯

主办： 国家集成电路设计西安产业化基地  
陕西省半导体行业协会  
西安市集成电路产业发展中心  
西安集成电路设计专业孵化器有限公司

[内部资料]  
2010 年第 4 期(季刊)  
总第 4 期  
2010 年 12 月 30 日

---

## 内容提要

### 活动回顾

- 西安成为 2011 年 IC CAD 年会举办城市
- 《陕西省集成电路产业“十二五”发展规划》专家论证会圆满召开
- 我基地组团参展第八届中国国际半导体博览会暨高峰论坛

### 会员动态

- 李克强视察我协会企业 强调发挥人才宝贵资源 抢占发展制高点
- 我协会理事长郝跃获“何梁何利基金科学与技术进步奖”

### 焦点关注

- 深度关注 IP 培育国产品牌 西安续接产业发展大旗

### 地方资讯

- 西安建首个物联网产业园 将打造完整产业链
- ADI 签约西安 设立中国第三家研发中心

### 产业动向

- 软件集成电路产业“新 18 号文件”年底出台
- 中国 IC 业蓄势待发 仍需着力提高国产化率
- 物联网引发新浪潮 产业发展需规划先行

### 公告通知

- 西安市科学技术局关于申报 2011 年西安市科技计划项目的通知

## 西安成为 2011 年 IC CAD 年会举办城市

历经紧张筹备，2011 年 IC CAD（中国半导体行业协会集成电路设计分会）年会举办城市终于尘埃落定。西安脱颖而出，成为 2011 年 IC CAD 举办城市。

2011 年年会是继 2005 年之后第二次在西安举办，经历了“十一五”的发展，2011 年年会将作为“十二五”开局之年再次见证西安集成电路产业这 5 年来的发展，显得弥足珍贵，同时，对西安集成电路设计业“十二五”发展而言更是奠定了坚实的基础。

国家集成电路设计西安产业化基地是西安集成电路设计产业的主要推动者，作为 2005 年和 2011 年 IC CAD 年会的申办组织及承办方，对于本地产业发展及 2011 年年会举办肩负着重要的责任，如何凭借 IC CAD 年会增进行业交流，集中资源，互通有无，实现产业新十年创新发展将成为基地未来努力的目标。西安历来有着利于产业转移与深厚的集成电路设计基础优势，期望通过 ICCAD 年会与业界精英一起探讨，共同努力，共促西安乃至中国集成电路设计产业的大步发展。

## 《陕西省 LED 产业“十二五”发展规划》专家论证会圆满召开

9 月 10 日，在陕西省工业和信息化厅太阳能光伏产业处处长任钧恩的主持下，《陕西省 LED 产业“十二五”发展规划》专家论证会在西安圆满召开。本次会议由陕西省工业和信息化厅太阳能光伏产业处组织，省财政厅、省电子信息产品监督检验所、西安市科学技术局、省半导体照明产业联盟等相关职能部门、省电子信息集团有限公司及相关企业、西安高新技术产业开发区经发局、西安国家民用航天基地招商局、西安交通大学、西北工业大学和陕西科技大学的教授组成专家团，共同就《陕西省 LED 产业“十二五”发展规划》内容进行讨论，并提出宝贵意见。期间，陕西省工业和信息化厅副厅长许蒲生出席并对规划提出了恳切意见，西安市集成电路产业发展中心作为编写组参加了此次会议。

LED 作为“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入国家中长期规划第一重点领域，更是“十二五”期间陕西省工业经济重要的增长点，此次论证会针对产业现状及高瞻远瞩的未来五年发展，深入讨论了规划的可行性，针对如何进一步发挥本地优势自主创新、产业发展目标、资本支持政策及措施、产业转移等问题进行重点讨论，并各自发表了意见。

此次论证会议的圆满召开，使《陕西省 LED 产业“十二五”发展规划》的后期实施更加贴合我省特色，为陕西省 LED 产业更好发展奠定了良好的基础。

## 我基地组团参展第八届中国国际半导体博览会暨高峰论坛

2010 年 10 月 21 日上午，第八届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(IC China 2010)携手苏州电子信息博览会在美丽的金鸡湖畔苏州国际博览中心正式拉开序幕。

本着宣传西安企业和产品、为西安集成电路企业服务的目的，西安代表团由西安高新区和国家集成电路设计西安产业化基地组织了六家企业参加本次博览会。西安华芯半导体有限公司、西安明泰半导体科技有限公司、西安翔腾微电子科技有限责任公司、西安西谷微电子有限责任公司、西安优势微电子有限责任公司、西安龙芯电子科技有限公司等六家企业分别展示了本公司的产品及研发实力。

展会期间，中国半导体行业协会名誉理事长、科技顾问俞忠钰、中国半导体行业协会理事长江上舟、中国半导体行业协会副理事长徐小田、中国半导体行业协会秘书长陈贤等行业专家分别参观了西安展台，深入了解了西安企业的发展情况，并给予西安企业很高的评价。特别值得一提的是西安明泰半导体科技有限公司被评为“IC China2010”优秀参展展品奖。

参加本次盛会不仅宣传了西安集成电路产业环境、发展状况及优惠政策、人才优势，还使本地企业及时获得了市场信息，了解了市场需求以及业界最新动态，对企业及时调整产品结构和市场策略有极大的帮助。

## 《陕西省集成电路产业“十二五”发展规划》专家论证会圆满召开

11 月 12 日，《陕西省集成电路产业“十二五”发展规划》专家论证会在西安水晶岛酒店召开。

本次论证会专家组由省工信厅组织，省科技厅、省财政厅、省质量技术监督局、西安高新技术产业开发区管委会、西安经济技术开发区管委会、西安国家民用航天产业基地管委会、西安电力电子所、中国航天时代电子公司 771 研究所、西安电子科技大学以及 5 家公司组成，共同就《陕西省集成电路产业“十二五”发展规划》内容进行论证，并提出宝贵意见。

论证会由省工信厅电子信息与软件服务处高翔处长主持，西安市集成电路产业发展中心参加了此次会议，并就编写思路与各位专家交换了意见。专家组认真听取了我中心对规划内容和编写思路的介绍，提问答疑，充分讨论，促进该规划的全面实施和稳步推进为我省逐步实现 5 年规划任务打下坚实基础。

集成电路产业是我国加快培育和发展战略性的新兴产业，也是培养电子信息产业新的增长点，作为陕西省“十二五”期间工业经济重要的增长点，此次论证会针对如何进一步发挥本地优势自主创新，以及产业发展目标、资本支持政策及措施、产业转移等问题也进行了重点讨论

## 李克强视察我协会企业 强调发挥人才宝贵资源 抢占发展制高点

10月28日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强考察了陕西省半导体行业协会的重点会员单位-----西电捷通和西安炬光科技。

西电捷通的网络安全技术目前已达到国际先进水平，并获得了国际标准证书。视察中，李克强与研发人员就信息网络、技术标准等问题与大家讨论交流，当看到西电捷通刚刚获得的国际标准证书时，李克强十分高兴，他表示：“这个证书的背后，凝聚了大家的创造、付出的心血和汗水，希望你们不断攀登新高峰，取得新成绩。”在西安炬光科技公司，李克强详细了解了炬光在国内外享有盛誉的半导体激光器及应用产品的性能、技术研发、市场前景等情况，对企业取得的成果表示肯定。他说：“高新技术产业是运用大脑、凝结智慧的产业，要发挥好人才这一宝贵资源的作用，顺应国际新趋势，加快科技成果的产业化，积极发展战略性新兴产业，培育新的经济增长点，增强自我发展能力，抢占发展制高点。”

考察中，李克强充分肯定了陕西省近年来经济社会发展取得的成绩，希望陕西把握深入实施西部大开发战略的重大机遇，锐意进取，开拓创新，在加快转变经济发展方式中实现新跨越、谱写新篇章。

## 华晶电子太阳能光伏材料加工基地扩产

10月29日，国内首家从事多线切割机应用企业——西安华晶电子技术有限公司太阳能光伏材料加工基地扩产一期工程在西安高新区落成。该项目的建成投产，将极大地提升陕西和西安高新区的行业影响力。另外，由高新区管委会、陕西光伏企业联盟主办的太阳能光伏企业发展经验（西安）交流会成功举行。

华晶电子太阳能光伏材料加工基地扩产项目投资3.6亿元，2009年10月13日开工建设，集办公、生产为一体，主要用于30台多线切割机、30台单晶炉的生产以及工艺配套。年产硅片200MW，将实现年销售收入10亿元，年产值12亿元。

西安华晶电子技术有限公司成立于1998年，公司产品为硅切片、研磨片，产品广泛应用于太阳能电池制造、二极管、三极管、可控硅等。今年1—8月已实现销售收入3亿元，预计全年将实现销售收入6亿元，利润4000万元。目前年产半导体用硅片1000万片，太阳能电池用硅片8400万片。

## 我协会理事长郝跃获“何梁何利基金科学与技术进步奖”

2010 年度“何梁何利基金”颁奖大会于 10 月 20 日在北京钓鱼台国宾馆举行，中共中央政治局委员、国务委员刘延东，全国人大常委会副委员长路甬祥，全国政协副主席、科技部部长万钢，全国政协副主席何厚铨等出席颁奖大会并为获奖代表颁奖。此次全国共有 51 名科技人员获奖。其中，我半导体行业协会郝跃理事长获得了“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

初设于 1994 年的何梁何利基金，是由香港爱国金融实业家何善衡、梁金求、何添、利国伟先生共同捐资 4 亿港元，专门为奖励中国内地科学家而成立的公益性科技奖励基金，因其规范的运作、严格的标准，具有公信力和权威性的评选记录，被誉为具有中国特色的诺贝尔奖。何梁何利基金自 1994 年创立以来，公信力和权威性日益增强，已经成为激发科技人员创造力、推进科学技术创新的特色品牌，成为促进祖国内地与港澳地区科技合作和共同发展的重要途径。今年的奖励覆盖范围更广，结构更趋合理，创新成果更加丰硕。据悉，今年是何梁何利基金创立第 16 年，到今年为止，已诞生了 901 位获奖者，其中，“科学与技术成就奖” 28 位，“科学与技术进步奖” 782 位，“科学技术创新奖” 91 位。

## 我协会会员单位通过陕西省 2010 年第一批高新技术企业认定

2010 年 11 月 15 日，陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合发文公布 2010 年第一批高新技术企业认定名单。其中，我协会会员、西安英洛华微电子有限公司、西安佰人科技有限公司和西安麟字半导体照明有限公司 3 家企业通过高新技术企业认定。

申请高新技术企业认定所享有的优惠政策有：

1、首先可以享受税收减免政策，已获得高新技术企业认证的单位可以减按 15% 的税率征收企业所得税；

2、有利于资格的认证，对产品的竞投竞标可以带来较大的推动效应；

3、有利于产品的宣传及品牌化认证；

4、有利于企业人才引进；

5、有利于研发费用的加计扣除；

6、有利于企业创新基金的申

## 深度关注 IP 培育国产品牌 西安续接产业发展大旗

-----展望 2011 年 IC CAD 在西安

12 月 1 日，“2010 中国半导体行业协会集成电路设计分会年会暨物联网与 IC 设计高峰论坛”在无锡华美达广场酒店隆重召开。国家集成电路设计西安产业化基地作为“8+1”基地中的一个，更是作为 2011 年中国半导体行业协会集成电路设计分会（以下简称 IC CDA）年会申办方参加了此次盛会。

本届年会分高峰论坛、专题研讨、产品展示三个部分，来自全球十多个国家和地区的近 50 家顶尖 IC（集成电路）企业展示了各自最新的产品与技术，知名企业的高层代表围绕产业现状、机遇与挑战、调整与创新、合作与共赢等相关议题，和与会代表分享了各自的观点。其中“IP 与 IC 设计 IP and IC Design”的主题分论坛吸引了众多的业内同仁，对 IP 的关注已经成为大家不约而同重中之重，从 IC CAD 理事会宣布西安申办成功，成为下届年会举办城市，从接过标有 ICCAD 标志的大旗开始，如何以区域优势为主，凭借年会平台促进中国及本地 IC 设计业发展，西安担负着一份沉甸甸的责任。

### 关注 IP：是我国产业增强竞争力之基石

中国集成电路产业已经成为全球半导体产业关注的焦点，凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及稳定的经济发展和优越的政策扶持等众多优势条件，近几年，取得了飞速发展。由集成电路产业带动下的移动互联网、三网融合、物联网以及云计算、电动汽车、新能源的广泛应用孕育了大量的新兴产业，为我国国民经济的持续、快速发展注入了新的活力。

但是我们也应注意这样一个事实：市场是我们的，技术却是别人的。全球集成电路业竞争格局已经从单纯的产品竞争向专利、知识产权（IP）转移，对于设计也来讲，以国情为依据、与产业政策相配套的知识产权战略将是我们增强核心竞争力的基石，也是我们壮大产业发展的主要途径。

同时，随着国内企业运用 IP 的能力不断提升，对 IP 不再局限于保护、管理等层面，而是转向更深层次—IP 资本运作。如何针对此类进步探索适于中国企业做好价值评估、探索实践 IP 融资方式方法等问题都将成为下届年会的主要议题。

### 策略之重：培育国产品牌

我国的集成电路产业主要集中在数字领域，而射频、模拟的高端技术基本都掌握在国外公司手中，这部分技术在产品架构中属于高附加值的。尤其是我国手机、便携机等移动设备市场发展迅猛的今天，发展本国的射频、模拟集成电路技术，进行该方面产品的研究，对于我国消

费类电子、军事、航天事业具有深刻的作用。从设计领域来讲，西安的设计业涵盖了物联网、通信、微处理器、信息家电、半导体照明、消费电子、设备制造、器件研发等多个领域，尤其在军工、航天领域有着得天独厚的优势，对于组织相关产业领域的 SoC/IP 产品的研发，引导产业方向，为产业的理性发展奠定基础方面，西安有着其巨大潜力和科技研发与创新的优势。通过年会平台促进投资引智、培育核心技术，对于西安乃至中国 IC 设计业都将具备战略意义。

“创造是制造的源泉，制造是创造的延伸，而集成电路设计是产品创新的源头”，中国半导体行业协会集成电路设计分会常务副理事长魏少军教授的总结充分说明了基于科研与创新对于中国 IC 设计业的重要作用。

### 深入合作：以人为本 引进高级人才

人才是促进我国集成电路产业并持续发展的根本保证，制约我国 IC 设计产业高速发展也是人才的短缺，人才的自身素质也是 IP 使用和交易中极为重要的环节。西安自上世纪 70 年代以来，一直是我国重要的教育科研基地，综合科技实力居全国前三，其中西安交大、西安电子科技大学和西北工业大学是国家集成电路人才培养基地（全国共计 15 所），数量与北京、上海并列第一。通过 IC CAD 年会交流平台，提升人才交流层次，凭借本地人才优势建立一套全方位的人才培训体系，在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，协助企业培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。通过定期的组织行业、地区交流，技术、管理培训，为中国 IC 设计业培养不同层次的 IC 人才，增强国内 IC 行业的技术水平。正如中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长王芹生女士所说，“我们必须实施大品牌战略，建设从创造到制造的完整产业链，用创新迎接集成电路产业的未来。“以人为本”是未来集成电路市场的发展趋势，也是将我国建成集成电路产业强国的强大驱动力。我们相信在“以人为本”的不断创新中，在不久的将来，中华民族的伟大复兴一定能尽快实现”。

### 探索和实践：新的商业模式

战略性新兴产业的发展离不开集成电路，也为集成电路创造了全新的发展空间。集成电路责无旁贷的要担负起支撑产业升级，经济结构调整、发展模式转变的重任。显然，在这个全新的领域，集成电路设计企业要用创新的思维去积极探索和实践新的商业模式，走出一条新路。2010 年是“十一五”收官之年，2011 年是“十二五”开局之年，如何更好的实现“十二五”产业规划任务及战略发展目标也是 2011 年年会需要重点关注的方向。

西安产业状态无疑有着与中国相似的产业现状态势----基于巨大的 IC 需求市场，本地 IC 设计企业面临市场的瓶颈问题，如何探索和逐步加强设计企业和整机厂商的互动，增强整机厂商对国产集成电路产品的信任度，从而一步一步的循序渐进的深入合作，扩展设计企业的业务，从而有效保证自身的发展延续性，“摸着石头过河”探索并实践出一套利于自身发展的商业模式也将是西安承办 2011 年年会的一个重要目标之一。

## IP 核是我国 IC 产业发展重中之重

IP 核是指集成电路设计中预先设计、验证好的功能模块，由于性能高、功耗低、技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵，是集成电路设计产业的最关键产业要素和竞争力体现。随着超大规模集成电路设计、制造技术的发展，集成电路设计步入 SoC 时代，设计变得日益复杂，为了加快产品上市时间，以 IP 核复用、软硬件协同设计和超深亚微米/纳米级设计为技术支撑的 SoC 已成为当今超大规模集成电路的主流，当前国际上 90% 以上的 SoC 都是采用以 IP 核为主而进行设计的，IP 在 IC 设计与开发工作中已是不可或缺的要素。根据 Gartner 的统计，2009 年全球 SOC 市场规模约为 800 亿美元，2010 年将超过 900 亿。与此同时，2009 年 IP 销售额也已经超过 20 亿美元，且以每年 15% 左右的速度递增，我国 IP 核市场约为 2.98 亿元人民币，约占全球市场的 2.64%。

这几年我国的 IP 核产业已经成为 IC 产业中增长最快的一部分。但是由于国内 IP 核产业起步晚，缺乏核心技术，在市场上依然处于非常被动的局面，发展具有自主知识产权的 IP 核有利于推进国内 IC 设计及制造业的发展，是我国 IC 产业发展的重中之重。而发展国内 IP 核，关键在于进一步完善国内 IP 发展的生态环境建设。作为目前亚太地区最具规模、技术水平最高、影响力最大的 IP 研讨盛会，SSIP2010——IP 重用技术国际研讨会成功举办，为国内外的 IP 供应商和 IC 设计企业之间提供了一个信息共享和商务沟通的平台；凭借此平台，双方共同畅谈中国 IP 市场的现状与需求，探讨 IP/SoC 的最新成果及其交换交易的商务模式，推动技术创新与商务合作，从而协助营造国内外的以 IP 为核心内容的合作创新环境的建立，以加速提升产业创新发展的能力，其成果必将为全国 IC 设计业乃至创意产业、先进制造业、现代服务业的又好又快发展注入创新要素和新的活力。



## 西安建首个物联网产业园 将打造完整产业链

近日，西安未央物联网产业园发展有限公司正式签约，将在未央区建设陕西省首个物联网应用产业园。

西安未央物联网应用产业园是依托西安市现有科研优势，发展战略性新兴产业的示范园区。园区重点发展超高频 RFID、高端传感器、3G 和下一代互联网等产业，努力打造物联网标示、感知、信息处理、传送及应用的完整产业链。

基地建成后，区内企业可借助于物联网应用平台发布、查询和接收各项业务信息，以提高企业的工作效率和业绩，通过信息共享，可以实现资源的整合与优化配置。对于尚无能力自建信息系统的中小型企业来说，物联网的应用服务提供商为其提供了应用硬件设施租赁服务，使其降低业务运行的成本。同时，为区内企业提供了在线交易的环境和政府各职能部门“一站式”服务的集成环境。

按规划，西安未央物联网应用产业园位于未央工业园内，计划 5 年内实现总投资 50 亿元，建成产业载体近 5 万平方米，主要为研发中心、产品展示中心等三大中心两大区的园区格局。

## 西安半导体照明试点工作实现跨越发展

截至目前，西安半导体照明示范应用工程 LED 灯具总投资已经达到 1.2 亿元，应用数量达到 3.5 万盏。通过示范工程的实施，西安培育半导体照明产品制造企业 34 家，初步形成了自主创新与产品应用紧密结合的半导体照明产业集群，取得显著品牌效应的本地企业获得长足发展。

从 2009 年 3 月陕西省西安市被列入科技部“十城万盏”试点城市以来，西安市有 15 个项目被列入半导体照明首批示范应用工程，LED 灯具总投资已经达到 1.2 亿元，应用数量达到 3.5 万盏。同时，通过示范工程的实施，培育半导体照明产品制造企业 34 家，初步形成了自主创新与产品应用紧密结合的半导体照明产业集群，取得显著品牌效应的本地企业获得长足发展。

鼓励能源管理、创新应用模式。目前，西安正在积极寻求合同能源管理模式的突破口，为打破 LED 路灯示范工程投入大、风险高的资金瓶颈，计划联合银行、保险公司、LED 企业，通过有效的组织协调，成立能源管理公司，从融资、税收、优惠政策及会计制度等方面支持节能服务行业的发展。同时，针对西安的地方特点，寻求新的创新管理模式。

## 合众思壮西安研发中心落成

10月27日，国内GNSS产业领军企业合众思壮在西安高新区投资建设的合众思壮西安研发中心正式落成，同时正式发布了“U系列”具有核心自主知识产权的全新GNSS产品，其中包含了多款兼容北斗系统的导航、授时板卡、模拟器，GPS测向/测姿仪、信号干扰器等。

合众思壮西安研发中心总建筑面积2.7万平方米，配备有7条SMT贴片线、5条组装线以及相关配套设施，专业从事卫星导航专业数据采集系列产品生产和测试。项目达产后，将年产手持型卫星导航数据采集器9万台，高精度测量设备5000台。

合众思壮新发布的GNSS产品具有兼容性，这几款GGB（GPS/GLONASS/BD）板卡，包括了兼容GPS/北斗系统的授时板卡UGB-RT，兼容GPS/GLONASS的UGG200，兼容GPS/GLONASS/北斗系统的三合一导航板卡UGG300，Uni-att-200/400GPS测向/测姿仪，GPS信号干扰器和兼容GPS/GLONASS/北斗系统的三合一模拟器Unisat-300等。此次合众思壮推出的GGB（GPS、GLONASS、北斗）高性能OEM板卡，充分考虑到我国卫星导航产业的长远发展，也为北斗试验性导航系统（北斗一代）到北斗区域性导航系统（北斗二代）的市场应用做好了铺垫。同时，这些产品还有具有高性能特点，打破了国际企业的垄断，突破了高度和速度限制，可以不限高度、不限速度地在全天候任何状态下实行高精度高动态导航，保障了我国的车载、机载、航空导航、高铁等市场的正常使用。

## ADI 签约西安设立中国第三家研发中心

2010年11月16日，全世界特许半导体行业中最卓越的供应商之一亚德诺半导体技术公司-Analog Devices, Inc.（ADI）在西安高新区管委会签约，设立目前ADI公司在中国的第三家研发中心。

ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商，拥有遍布世界各地的60,000客户，涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路（IC）制造商，ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。

截至目前，ADI公司在中国仅拥有200人的团队，但2010财年在中国的销售收入已到达5亿美元的规模。ADI公司自从1965年创建以来到2005年经历了悠久历史变迁，取得了辉煌业绩，树立起成立40周年的里程碑。从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步——经过40多年的努力，发展成全世界特许半导体行业中最卓越的供应商之一，将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱，并藉此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。

## 西安“半导体”蓄势扩张“不差钱”

丰富的人力资源和良好的投资环境，正一步步把西安尤其是高新区变成关中一天水经济区域内的“聚宝盆”。就在越来越多的世界知名企业和产业巨头投资西安时，继美国美光科技公司“砸下”3 亿美元发展半导体测试项目之后，韩国 SIMMTECH 公司昨日也掷金 1.01 亿美元，在西安建成该公司本土以外的第一个半导体零部件项目生产基地，西安为此新增就业近千人，也预示着西安半导体蓄势扩张“不差钱”。

## 西安 LED 蓝宝石基板及后续项目开工

近日，西安 LED 蓝宝石基板及后续项目开工，本项目由国际 LED 领域著名科学家张汝京领衔，陕西神光新能源投资有限公司出资，总投资 40 亿元，所涉及开发生产的产品包括蓝宝石基板、新一代半导体外延片、芯片及测试、封装光源等。

该项目建成后将填补国内优质 LED 衬底材料生产空白。项目一期年产蓝宝石基板 210 万片以上，预计 2011 年第二季度投产，项目一期投资 4.5 亿元人民币达产后，年销售收入将不低于 4000 万美元。

## 半导体:

### “十二五”中国半导体产业投资超 2700 亿元

中国半导体行业协会表示,“十二五”期间,我国半导体行业的投资有望超过 2700 亿元,较“十一五”增加 1 倍。

全球前 3 大 MOCVD 制造商 Aixtron、Veeco 及大阳日酸,09 年市占率分别为 68.3%、25.6%、4.5%。大阳日酸 12 年 MOCVD 销售目标 100 亿日元,为 09 年的 3 倍。

意法半导体表示,不计存储芯片在内的全球芯片市场预计 10 年增幅将在 20%至 30%之间,11 年将增长 5%至 10%,并认为该公司业绩仍将好于同业。

资策会产业情报研究所(MIC)预估,10 年中国 IC 设计业产值将达 321.5 亿元,年增长 19.1%,占 IC 产业的 21.8%。同时预估中国芯片市场从 10 年到 12 年的增长率分别为 17.5%、13.5%、10.4%,年复合增长率超过 10%,优于全球平均。

DIGITIMES 表示,在苹果带动的多点触控投射电容热潮下,10 年、11 年两岸触控面板控制 IC 厂商出货量将分别达 1800 万颗、5043 万颗,同比分别增长 163.5%、180.2%。

1-9 月国内元器件各细分产品 PCB、电容、电阻、电感器件、电声器件、磁材料及器件、电接插元件出口同比增长分别为 37.00%、50.15%、44.92%、58.75%、38.37%、44.99%、40.63%。

美国电子工业联接协会的最新数据显示,10 年 9 月份北美地区 PCB 行业三月移动平均的订单出货比为 1.03,较 10 年 8 月份下降 0.04,连续 17 个月保持在 1 以上。

IDC 最新报告显示,10Q3 全球手机出货量 3.405 亿部,相比去年同期的 2.971 亿部增长 14.6%。

易观智库数据显示,10Q3 中国手机移动互联网用户达 2.43 亿人,同比增长 39.00%,环比增长 13.15%。智能手机保有量增长至 8870.8 万台,环比增长 21.1%。

StrategyAnalytics 最新报告显示,10Q3 全球智能手机销量达 7700 万台,创下历史新高,同比增长 78%。

### 中国 IC 业蓄势待发 仍需着力提高国产化率

“尽管近年来半导体制造工厂的建设推动了中国集成电路产能的扩张,但由于市场需求的增长速度更快,中国集成电路生产和需求之间的缺口仍在拉大。”在 11 月 4 日由北京市经济和信息化委员会主办的 2010 北京微电子国际研讨会上,SEMI 全球执行副总裁丹尼尔·马丁向与会人士发表了演讲,“在 2004 年,中国集成电路的供需缺口为 360 亿美元;而到了 2009 年,供需缺口加大到了 670 亿美元,5 年之间几乎翻了一番。”的确,中国进口集成电路的金额早已超过了进口石油等能源产品的金额,因此需要着力提高集成电路的国产化率,而这必须在产

品创新、工艺提升、产能扩张等方面做足文章。

## 中国集成电路产业将迎来大发展

2000 年以来，信息产业部组织实施了“中国芯”工程，大力扶持国内具有自主知识产权 IC 产品的研发。国家科技部在 863 计划中安排了集成电路设计重大专项。在 863 计划集成电路设计重大专项的实施和带动下，北京、上海、无锡、杭州、深圳、西安、成都等七个集成电路设计产业化基地的建设取得了重要进展。

2008 年下半年爆发的国际金融危机使中国半导体产业面临严重挑战，去年全年中国集成电路总产值罕见地出现负增长，下滑幅度超过 10%。但随着国家的拉动内需政策的刺激以及国际市场环境的回暖，2009 年 IC 产业呈现了显着的触底回升的势头。

从 2009 年一季度产业出现最低点之后，开始进入回升。四季度迅速好转，出现了 39.8% 的正增长。在家电下乡、三极管的建设、以旧换新等一系列刺激内需政策的拉动下，2009 年 IC 设计业逆势增长。

市场调研机构 iSuppli 公司的猜测表明，随着电子产品出口从国际金融危机中复苏，中国半导体市场有望在 2010 年大力反弹。2009 年，在中国政府经济刺激计划的扶助下，液晶电视、白色家电、汽车、通信等市场受益良多，与这些领域相关的半导体芯片市场也实现了快速增长。

## 国产 65nm 大角度离子注入机进入晶圆生产线

由北京中科信电子装备有限公司自主研发的 300mm/65nm 大角度离子注入机进入中芯国际(北京)集成电路制造有限公司，开始接受国际主流生产线的技术测试与器件工艺检验，为这一国产集成电路制造装备实现重大技术跨越作最后的冲刺。

据了解，这是国产高端离子注入机首次进入 300mm 主流生产线，表明国内的离子注入机研制已经逐步达到世界主流技术水平。

北京中科信公司研制的 65nm 大角度离子注入机以满足大规模生产线 65nm 制程工艺需求为目标，以提升产品工艺性能、整机可靠性及降低成本消耗为设计理念。在不到两年的时间里，北京中科信电子装备有限公司研发团队成功突破了多项关键工艺，完成多项核心研究，实现了设备的工程化制造、关键零部件国产化，完善了系统设计、系统加工、系统集成流程，保证了设备的高可靠性及工艺水平。

长时间的系统的性能测试结果表明，整机生产率、控制精度、软件可靠性、整机自动性能、工艺一致性等指标都有了显著提高，整机性能完全达到甚至部分已经超过了项目合同要求，同时适应国际 300mm 工艺生产线标准要求。

光伏：

## 我国太阳能光伏关键设备国产化获重大突破

日前，中国电子科技集团公司（简称中国电科）48 所承担的电子信息产业发展基金《多晶硅铸锭炉开发及产业化》项目及《大口径闭管高温扩散/氧化设备》项目顺利通过验收，实现我国太阳能光伏产业关键设备国产化的重大突破。

多晶硅铸锭炉是光伏产业链前端的关键设备。《多晶硅铸锭炉开发及产业化》项目的实施，中国电科 48 所克服重重困难，攻克了多晶硅定向凝固工艺技术、高洁净炉膛技术、晶体硅生长系统的热场技术、精密传动技术等一系列技术难题，开发出具有完全自主知识产权的多晶硅铸锭炉，申请了多项专利。该设备的研制成功，是我国太阳能光伏产业关键设备实现国产化的一次重大突破，解决了我国大规模生产多晶硅锭的技术瓶颈，满足国内对该设备的迫切需求，节约了大量外汇，可形成一个新的高技术产品集群，完善我国的光伏产业链，带动国家光伏产业整体水平的提升，取得了显著的经济和社会效益。

## 中国光伏制造产量将占全球市场半壁江山

国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰 11 月 18 日在南京举行的第十一届中国光伏大会上表示，今年中国的光伏产品制造产量将占全球产量的 50% 以上。

从 2004 年开始起步，中国的光伏制造产业从当年占全球产量的不足 1% 到今年有望超过 50%，中国仅用了 6 年时间。无锡尚德董事长施正荣在光伏大会上表示，2010 年全球光伏装机容量“保守估计”约 12.2GW（1220 万千瓦），同比增长超过 65%。其中，作为全球最大光伏市场的德国，今年有望实现装机 7GW，与去年全球装机容量相当。

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦此前曾在公开场合表示，预计今年中国的光伏组件制造产量将达到 7000-8000 兆瓦，实现“翻番”增长，若以此计算，中国今年的光伏组件产量将占全球的大约 57%。

国家能源局此前曾预测，今年中国的光伏累计装机量或达 60 万千瓦（600 兆瓦），实现翻番增长。尽管如此，600 兆瓦与今年中国预计的 7000-8000 兆瓦产量相比，仍不足一成。

## 世界各国最新光伏新政面面观

欧美国家近几年对光伏发电的补贴政策直接促发了太阳能产业的勃兴。而自 2010 年起，欧洲主要太阳能应用企业正在纷纷退出或者逐渐削减补贴比例。这对以欧洲为重要市场的中国企业是严峻考验。

2010 年 7 月 1 日起，德国对屋顶光伏系统和和移除耕地农场设施的补贴额将减少 13%，对转换地区补贴额将减少 8%，其他地区将减少 12%。从今年 10 月 1 日开始，总补贴额进一步减少 3%。

8 月，西班牙计划削减太阳能上网电价幅度达 45%，对大型屋顶太阳能光伏装置的上网电价将下降 25%，小型的则下降 5%。

9 月，捷克出台政策，规定明年 3 月，建在农业用地上的太阳能发电厂将不再获得政府补贴，预计将减少 700 兆瓦太阳能电站的投资。

同月意大利决定在 12 月 31 日开始削减对太阳能光伏项目的补贴。

10 月，国外媒体称，英国政府将大幅下调公共开支，其中，太阳能补助名列其中。

追随德国的脚步，未来几年，欧洲的需求将经历先高后低的市场波动。为了赶上每个国家对光伏补贴的末班车，短期的订单量提高和产能释放可以预见。但长期来看，上半年欧元对人民币累计贬值 20% 和产业补贴政策的不确定性都加重了国内光伏出口的负担。产业补贴政策对内可以协调财政支出的利益平衡，对外作为国与国之间的博弈手段。以西班牙为例，政府迫于财政压力削减光伏发电的补贴后，西班牙的装机量从 2008 年的 2600MWp，直线下跌到 2009 年的 70MWp。

美国作为光照最丰富的国家之一，虽然发展光伏产业比日本、德国晚得多，但市场潜力巨大。为此，2010 年 7 月 21 日，美国参议院能源委员会投票通过了“千瓦屋顶计划”，从 2012 年到 2021 年累计投资 50 多亿美元。

可以说，各国政府针对光伏产业的政策既有利好也有利空。国内光伏组件出口市场参与者应当积极关注中国能源规划和光伏发电项目的各类计划，还要时刻了解国外主要光伏组件进口国的市场变化。

**LED:****半导体照明芯片国产化率将达七成**

国家 863 计划新材料领域专家组首席专家徐坚，日前在深圳“自主创新大讲堂”上透露，根据“十二五”规划，半导体照明工程到 2015 年芯片国产化率将达 70%，产业规模达到 5000 亿元，相关企业面临着巨大商机。

徐坚在《国家新材料产业发展的“十二五”规划思路》专题报告中指出，新材料“十二五”规划从技术导向转为以产业和经济需求为牵引，围绕“应对金融危机、推进绿色制造、支撑产业升级”的思路，推进基础性重点原材料产业结构调整与升级。

他透露，半导体照明工程到 2015 年芯片国产化率将达 70%，形成百亿元以上芯片企业与百亿元以上应用企业体系，实现年节约用电 1000 亿度，产业规模 5000 亿元。在先进显示领域，2015 年国内将形成激光显示技术和产业体系，构建 OLED 大规模生产线体系，显示共性技术和配套材料将带动 6000 亿至 8000 亿元产业链。高性能电池方面，将攻克关键技术，开发大战略产品和技术系统，形成网络化的战略产品技术群与核心专利池，构建高端电池研发和产业化基地，2015 年力争实现高性能电池（材料）产业规模千亿元以上。稀土功能材料方面，产值规模将达 500 亿元，高端稀土功能材料 5 年总产量达 100 万吨，带动相关行业产值 1.5 万亿元以上。

**中国半导体照明产品应用示范工程项目中标入围结果公示**

2010 年 8 月，中国国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅及交通运输部办公厅联合发布了《关于组织申报半导体照明产品应用示范工程项目的通知》。近日，公示出招标入围名单，包括 LED 道路/隧道灯、LED 筒灯、反射型自镇流 LED 灯三大类产品，涉及企业共 28 家。

11 月 10 日，由中国电子进出口总公司代理的半导体照明（LED）产品应用示范工程产品入围招标项目公开开标，拟在在不同气候条件的地区，选择 20 个半导体室内照明应用项目、15 个半导体路灯应用项目和 15 个半导体隧道灯应用项目开展示范。吸引了 94 家照明生产企业参与角逐。最终分别是北京朗波尔光电股份有限公司、宁波燎原灯具股份有限公司、江苏史福特光电股份有限公司、西安立明电子科技有限责任公司、浙江生辉照明有限公司、浙江求是信息电子有限公司、上海三思电子工程有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司、东莞勤上光电股份有限公司、山西光宇半导体照明有限公司、深圳市斯派克光电科技有限公司、浙江晶日照明科技有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、浙江名芯半导体科技有限公司、浪潮集团有限公司、四川格兰德科技有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、惠州元晖光电有限公司等 28 家企业最终入围。



## 第三季 LED 背光模块渗透率达到 26%

大尺寸 LCD 的出货量在 2010 年第三季降到 1 亿 6 千 3 百万片，较前季下降 4%，但与去年同期相比则呈现 7% 的成长。营收数字达到美金 213 亿元，较前季下滑 7%，但与去年同期相比则成长了 7%。

按应用别来看，显示器和笔记型计算机的出货量较上一季下滑，但是第三季液晶电视和平板计算机的应用持续成长。笔记型计算机较前季下滑了 14%，是有史以来最大单季下滑，而显示器较前季下滑了 8%。这两个应用产品的面板价格从 7 月到 10 月间呈现显著的下滑，估计要到 11 月才会开始稳定。9.7 吋面板出货量大幅上扬，使得迷你笔电和平板计算机的出货量较前季成长 8%，整体出货量从 2010 年第二季的 3 百万片，成长到第三季的 5 百 60 万片。

虽然市场呈现供过于求情况，然由于品牌厂商针对年底销售旺季促销机种寻找低成本方案所达成的特殊交易量增加，使得第三季液晶电视面板出货量仍是上扬的，特别是 40 吋以上机种与 LED 背光机种。第三季 40 吋及以上尺寸液晶电式面板出货量达到 1 千 810 万片，较第二季 1 千 6 百万片增长了 13%；其中 LED 背光面板出货量达到了 780 万片，较上一季增长 2 百万片。

## MOCVD 技术当前的趋势与未来前景

今年，中国 LED 企业在上游芯片领域动作层出不穷，纷纷启动了建厂、扩厂计划。据悉，中国购买 MOCVD 的订单已经排到三年之后。业内专家认为，随着未来大量的 MOCVD 投产，芯片价格会下降，这对产业是利好消息，但是哪个企业最终抢占商机，人才是最关键的因素。买来的 MOCVD 质量如何？型号是否先进？下一代的 MOCVD 技术的趋势是什么？这些都是企业应该思考的问题。

未来的半导体照明市场将会保持年增长率 31% 的速度，这将大大推动半导体照明技术的发展。大尺寸衬底是未来发展趋势，因为它符合价格降低、提高产能、高程度自动化及最大程度利用硅衬底的需求。目前 2 英寸和 4 英寸还是市场主流，但是有些公司已经开始考虑 6 英寸，甚至开始着手做 8 英寸的设计。

## 物联网：

### 物联网引发新浪潮 产业发展需规划先行

#### 物联网具有广阔的应用前景

物联网是在互联网的基础上发展起来的，不少专业人士把物联网称之为世界信息产业的第三次浪潮，是信息产业新一轮竞争的核心领域。预计 10 年内物联网会大规模普及，发展成为一个上万亿元规模的高科技市场，其产业规模比互联网大 30 倍。美国咨询机构 FORRESTER 预测，到 2020 年，世界上“物物互联”的业务，跟人与人通信的业务相比，将达到 30 比 1。

从应用范围看，物联网可以广泛应用于农业、交通、安防、物流、零售、电力、金融、环保、公共安全、工业监测、医疗等领域。在具体的管理实践上，物联网至少可以解决以下管理问题。一是可以强化现场的实时监管，便于及时了解各类物质设施与周围环境的状况。

#### 物联网产业的发展需要突破关键技术

我国在物联网研发与应用方面起步较早，各地发展积极性较高，产业发展有一定的规模，影响产业发展的主要问题在于关键技术创新的瓶颈约束。但物联网产业的市场前景引起国内外的广泛关注，各地都注意加强物联网方面的技术创新。

目前中国的物联网产业存在的问题不只是技术层面的，正如一些权威专家指出的，统筹规划和顶层设计缺乏、标准规范缺失、规模化应用不足、商业模式缺乏、产业链不完善等问题亦存在。在产业发展上还存在着哄而上、各地自建标准、各行其是、市场严重分割等问题，致使正常的市场竞争效率不能有效发挥。这些，都对物联网产业的未来发展产生一定的影响。

#### 加强政府对物联网产业发展的引导与支持

在全球经济处于由低谷转入恢复性增长之时，新兴产业通常在整个经济增长中处于重要地位，目前的物联网产业具有这样的产业特质。在中国，物联网技术已经被列入国家级重大科技专项，物联网产业也被列入国家重点发展的战略性新兴产业。从加快经济发展方式转变和调整与优化产业结构的角度看，还应该加强政府对物联网产业发展的引导与支持。

在具体的政策实践上，应该加强总体设计，可在“十二五”规划中加强物联网产业的规划；推进物联网技术标准、应用标准与行业标准的设立。对外应该参与全球标准的制定，增强在规范物联网产业标准方面的话语权。对内加快制定国家标准，以引导和规范行业发展；应该打破地域封锁格局，促进企业跨地区的友好竞争与合作；应该积极推进一批政府示范工程的建设，发挥重大项目对产业扩张和技术创新的引导功能；积极推进产学研一体化进程，支持关键环节

与重点产品的技术创新，重视感知领域的技术创新，争取在芯片等产品的技术创新方面取得突破；建立物联网的投融资平台，支持企业通过广泛融资尽快做大做强。

## 探索运营商每个产业的阶段发展规划

3G 将为物联网提供更多的市场机会，远程视频监控、车载信息娱乐、远程信息显示和多媒体内容传送等应用可以充分利用高效的 3G 网络，成为 3G 时代的创新业务。

### 第一产业的探索与实践

以中国移动为例，已经开展的农业物联网应用包括动物溯源，温室监控，森林防火监控等。

农业标准化生产监测系统方面，面对国内日益频发的食品质量与安全问题，中国移动与农业部合作开发了动物标识溯源系统。该系统通过标识编码、标识佩戴、信息录入与传输、数据汇总、分析和查询，实现各环节一体化全程监控，达到动物养殖、防疫、检疫和监督的有机结合，从而能够对动物疫情和动物产品安全事件进行快速、准确地溯源和快速处理。

### 第二产业的探索与实践

在工业领域，比较成功的物联网应用包括工业监控、视频监控、企业安防等。

以中国移动为例，移动运营商面向电梯安全部门、电梯使用单位、电梯厂商和电梯维保单位等行业用户推出的电梯安全信息化管理产品。

通过安装在电梯外围的传感器采集电梯冲顶、蹲底、停电、关人等故障以及电梯维保信息，并通过无线传输模块将数据传输到电梯卫士平台。

由平台实现电梯运行安全监控、故障管理和维保管理等业务功能，帮助电梯安全管理部门、电梯厂商、维护单位和使用单位实现电梯安全的信息化管理，为企业主动防护综合管理提供了有力工具。

对用户来说不仅仅提供安防产品、企业管理小助手功能，还满足用户需要，把安防系统从单纯告警向运营管理发展。

## 产业政策:

### 软件集成电路产业“新 18 号文件”年底出台

软件及集成电路产业“18 号文件”即将到期。据悉，国家《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(即软件业“18 号文件”)的替代文件正在国务院接受审核，年底前肯定会出台。文件将新增“软件服务业”等内容。且伴随多项优惠政策信息。

2000 年发布的“18 号文件”，提出了对软件企业实行增值税优惠等在内的一批系统性扶持措施。过去 10 年，中国软件业年均增速高达 38%，这背后，“18 号文件”功不可没。

但由于制订较早，许多领域已失去效应，如目前发展迅速的软件服务业，就没有得到充分体现。此外，由于国家正在围绕物联网、云计算、SaaS(软件即服务)三大领域制订新的战略，原文件已无法容纳。

“新 18 号文件”有两大变化：一是适应产业发展的新形势，如加大对软件服务类企业的支持，以适应目前软件业“从产品向服务转型”的趋势，帮助他们开拓云计算等新兴领域；二是增加对集成电路产业的扶持，在“18 号文件”中，因为一些条款与 WTO 原则相冲突，涉及集成电路产业的部分政策已暂停执行多年，而新政将改变这一局面。

### 工信部推进信息产业发展集成电路急盼新政

“十二五”期间，工信部将出台进一步支持集成电路、软件、新型显示器件等重点产业发展的政策，从而加快信息产业发展。

工信部副部长奚国华日前在第七届海峡两岸信息产业技术标准论坛上做出以上表态。奚国华还表示，将支持整机和新型平板显示器件企业享受高新技术企业的税收优惠政策，并将发挥国家重大科技专项的牵引和带动作用，加强政策保障，充分利用有限资源，将之转化为现实生产力。鼓励和支持优势企业并购重组，整合资源，做大做强。

### 财政部取消 39 个金太阳工程项目

财政部 11 月 23 日表示，已取消 39 个总计 54 兆瓦的 2009 年金太阳工程示范项目，其中包括尚德、阿特斯、BP 等国际知名光伏企业担任业主的工程。

财政部公布的目录名单显示，洛阳尚德太阳能电力有限公司作为业主，承担的洛阳师范学院太阳能光伏建筑应用项目（1100 千瓦）已经因无法实施而被取消；洛阳机场二期光伏发电示范项目、洛阳新区图书馆光伏发电示范项目等 3 个由阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司实施的工程也被叫停。

其它被取消的项目还包括，碧辟普瑞太阳能公司（BP）在华合资企业在陕西省开发的总计 7300 千瓦的大明宫发电、火车北站光伏项目、咸阳机场项目以及商洛比亚迪榆林光伏发电项目；黄河上游水电开发有限公司拟在青海建设的 5000 千瓦示范项目；天津市津能电池科技有限公司在天津，北京市排水集团、北京市环卫集团等在北京的金太阳示范项目。

财政部、科技部、国家能源局于 2009 年 7 月联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。三部委计划在 2-3 年内，采取财政补助方式支持不低于 500 兆瓦的光伏发电示范项目。

## 我国半导体照明起步晚 将加强两方面工作

作为新材料产业的重要代表之一，半导体照明产业的发展已经在世界各国掀起高潮。中国的半导体照明产业起步晚，规模小，技术力量弱，如何能够在未来取得突破性发展？对此，半导体照明产业技术创新战略联盟秘书长吴玲表示，围绕产业链，以构建国家重点实验室和应用技术研究中心为载体，提升产业共性技术和集成技术研发能力，将是联盟这种新型组织形式引领产业发展的任务。

自 2003 年科技部牵头启动“国家半导体照明工程”以来，我国半导体照明产业取得了长足发展，初步形成了完整的研发体系和产业链，并在示范应用方面走在了前列。但面对激烈的国际竞争，我国半导体照明产业发展面临诸多问题，缺乏龙头品牌企业，中小民营企业占 80% 以上，规模小、资源分散、创新能力不足；研发投入不足，研发力量分散，缺乏产业共性技术研发平台；产业发展环境不够完善，检测、标准、认证体系尚未建立，国家与地方，跨部门、跨行业统筹协调不够。

“下一步联盟亟须做两个方面的工作：第一怎样实施技术支撑；第二怎样拉动和培育大市场。”吴玲指出，打通和围绕产业链构建技术创新链，根据半导体照明产业链条长、企业规模小，研发力量分散现状，创新研发体制和机制，围绕产业链在前后端建立两个开放的、国际化的公共技术研发平台，加强共性关键技术研发，实现下一代白光技术突破与应用集成创新。

## 战略性新兴产业将成为“十二五”经济主导方向

“十二五”期间，战略性新兴产业将独领风骚，并逐渐替代传统产业成为主导产业。2010年9月8日，国务院审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，确定了战略性新兴产业发展的重点方向和政策，并将加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入，同时还拟定了《战略性新兴产业发展规划》。

“决定”确定了七大具体的战略性新兴产业，即节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，并决定集中力量，加快推进。这些战略性新兴产业将替代传统产业成为经济先导产业。这些战略性新兴产业目前占我国 GDP 比重不到 2%，到 2015 年将升至 8%，数年后则有望升至 15%。

战略性新兴产业目前确定了七大重点领域，但每个重点方向之下又有若干不同的重点领域：在节能环保中，将重点突破高效节能、先进环保和循环利用；在新一代信息产业中，将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等；生物产业，将主要面向生物医药、生物农业、生物制造；高端装备制造业重点将发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备；新能源产业将主要包括核能、太阳能、风能、生物质能；特种功能和高性能复合材料将是新材料的重点发展领域；备受关注的新能源汽车，主要发展方向则确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车。

从各产业的具体表现看，比如在新材料方面，包括大飞机、高铁、新能源汽车等重点工程，以及三网融合、物联网、节能环保等重要产业，都需要应用各种新材料，其市场需求正在不断扩大，新材料产品进出口额也逐年攀升。这些新材料包括金属新材料、新型无机非金属材料、高分子及复合材料等。

又比如在新一代信息技术方面，物联网将成为最具市场前景的产业。物联网越来越受到投资者和市场资金的关注。随着投入力度的不断加大，各种利好政策亦随之向其倾斜。统计显示，中国 RFID（移动射频识别技术）市场需求已形成规模，2009 年中国 RFID 市场规模已达 85.1 亿元人民币，同比增长 29.3%，在全球居第三位，仅次于英、美两国。业内预计，不久后，智能电网、移动支付等行业，将率先普及物联网的商业应用。

可以预见的是，这七大产业将是中国各大、中型企业甚至是小型企业未来的财富“聚宝盆”，我们将看到大量资金向这七大产业涌入。

与此同时，未来中国产业领域传统大格局——“两高一资”（高能耗、高污染和消耗资源性）产业中的弱势企业，将被大规模地抑制、淘汰、兼并、重组；另一方面，战略性新兴产业的发展将如火如荼，影响巨大。未来的政策资源、金融资源、技术资源、人才资源等，都将向战略性新兴产业领域倾斜。

## 清华大学电子开关技术改善 MRAM 储存速度与功耗

来自北京清华大学的研究人员开发出一种新技术，号称能让 MRAM 的储存速度与功耗大幅改善；这种电子开关(electrical switching)技术写入位所需的能源较少。

上述新技术的基本概念，是将磁域开关“部分”开关、而非完全转换其磁场方向；北京清大的研究人员表示，这种方式仍能让 MRAM 储存二进制位，但所需的开关速度却快得多，所耗费的能源量也是会比一般状况少很多。

北京清大的研究人员证实，在他们的 MRAM 位单元提供一个电压，能让扇区障壁出现或是消失，用以储存信息。目前该团队正在加强透过让扇区障壁出现或消失所引起的电阻率改变，以优化其材料堆栈、期望可进行商业化。

## 我国开发出太阳能光伏电池用高振实密度银粉

日前从科技部国际合作司获悉，依托西北大学“光电技术与功能材料国家重点实验室培育基地”和“国家级光电技术与功能材料及应用国际科技合作基地”，由西北大学王惠教授主持的科技部国际科技合作专题项目“太阳能光伏电池用高导电性银粉材料的制备技术与工艺研究”，历经数年潜心钻研，通过小试、中试以及工业放大等过程，已成功开发出目前国际、国内市场上急需的高振实密度(2.5—4.8g/cm<sup>3</sup>)银粉材料。

该制备新工艺新技术，具有操作简单、节能、环保、一次投料量大、产量高、成本低和工艺设备无特殊要求等优点。工艺技术属国际先进，国内领先。由该技术制备的银粉材料具有球形度高、分散性好、粒度均一、振实密度高、导电性能优越等特点。通过多项严格的技术检测证明，多种规格的球形银粉产品可与进口产品相媲美，个别品种的性能高于同类进口产品。

该类银粉的成功开发填补了国内高振实密度球形银粉生产的空白，标志着我国将有自主知识产权的太阳能光伏电池前电极浆料用高振实密度球形银粉以及用其开发出的银浆料。

## 我国发明新型高电导率纳米粉体材料

日前从中国科学院长春应用化学研究所了解到，一种绿色环保型高电导率纳米粉体材料近日在该所研制成功，并获得国家知识产权局的专利授权。

据介绍，这种新型材料的全称为“高电导率铝掺杂氧化锌纳米粉体”，它具有高结晶度、均匀掺杂、形貌可控以及分散性和重复性好等特点，其体积电阻率最低可达  $1.5 \Omega \cdot \text{cm}$ 。该

材料在科学研究和工业生产中应用前景广泛，如电子设备上的透明导电电极、抗静电复合材料中的导电填料等，都能用到这种纳米粉体材料。

据了解，当前世界范围内对透明导电氧化物的需求量急剧增加，其中氧化锌基纳米材料因其具有无毒、低成本、颜色浅等优点，成为目前最富有发展前景的一类透明导电氧化物。但如何提高半导体氧化锌基的电导率以及如何制备形貌可控的氧化锌基纳米晶体，一直是困扰各国科研人员的难题。

## 首颗二维码解码“中国芯”诞生

福建新大陆电脑股份有限公司今天发布了全球首颗二维码解码芯片。它的诞生，标志着中国物联网技术以及二维码识读核心技术已取得重大突破。

工业和信息化部有关人士今天表示，这表明中国在二维码核心技术领域已达到国际先进水平。

据介绍，感知识别技术是物联网价值链的核心基础，条码技术则是感知识别技术的核心组成部分；而二维码作为高安全性、高信息容量、低成本的高端主流条码信息载体方案，有着巨大的推广应用空间和广阔的市场前景。长期以来，二维码识读核心技术为欧美国家所掌握，这在一定程度上制约了二维码技术在国内的发展与推广应用。新大陆公司于 1999 年开始进军条码技术应用市场，经过不懈的自主创新，实现了完全自主的二维码技术的突破。此次新大陆公司研发的二维码解码“中国芯”，可为物联网的识别认证提供技术保障。

据悉，新大陆公司今天还与全球第三大自动识别公司——意大利得利捷股份有限公司签署了战略合作框架协议书，双方将在技术、产品、管理等方面进行合作。

## 中国推首款系统芯片：性能超英特尔同级芯片

据悉，ARM 及广东新岸线公司今日在京发布了全球首款计算机系统芯片 NuSmart2816，该系统芯片采用了台积电 40 纳米技术制造。芯片内集成了双核 ARM Cortex A9 CPU、显卡等功能，性能高于英特尔及苹果同级别芯片，目前新岸线已与联想、惠普、戴尔等厂商开始终端研发计划，首批应用该芯片的产品将于年底面世。

新岸线公司表示，NuSmart2816 系统芯片不仅性能高于英特尔酷睿 E4300，功耗仅为 E4300 的 32 分之一，价格不到酷睿 E4300 的一半。此外据新岸线提供的数据显示，该芯片性能及功耗亦高于英伟达及苹果同样采用 ARM 架构的处理器产品。在一颗芯片上集成了 CPU、南桥、北桥、显卡、视频解码、硬盘控制器等功能，NuSmart2816 芯片功耗不足 2W，系统的功耗不足 6W。不仅适用于新型上网本、平板电脑、智能电视等新产品上，也能满足台式机、笔记本等传统主流计算机产品需要。



## 2011 年各 Foundry MPW 流片时间表

2011 CSMC MPW Schedule

Tech	Process	Fab	MPW 安排	1Q		
				Jan	Feb	Mar
0.13um	Logic/Mixed-Signal/ RF	8-inch	每季度		23	
0.18um	Logic/Mixed-Signal	8-inch	每两月	19		23
0.25um	BCD(25V)	8-inch	每季度			
	BCD(40V)	8-inch	每季度			
0.5umFE+0.35umBE	Logic/Mixed-Signal	8-inch	每季度			3
0.5um	BCD(15V)	6-inch	每季度		28	
	BCD(25V)	6-inch	每季度			9
	BCD(40V)	6-inch	每季度			16
	Mixed-Signal	6-inch	每季度	28		
1um	BCD (700V/500V)	6-inch	每季度			

Y2011 HuaHong NEC MPW Schedule

Technology			Core I/O	1H/2011		
				Jan	Feb	Mar
0.35um	CZ6H	Std. Logic	5V		HMP1C1	
		Mixed Signal				
		OTP				
	CZ6HFTSC	EEPROM	5V	HMP1A1		HMP1F1
	CA500CL	Low Vt	5V			HMP1G1
	BCD350/CL350G	BCD/Logic	5V/20V/40V			HMP1H1
	PMU350	CD	5V/20V/40V			HMP1I1
0.25um	EF250G	eFlash	2.5V/5V	HMP1B1		

0.18um	BCD180	BCD/Logic	1.8V/5V		HMP1D1
0.13um	EF/EE130	eFlash/eEE	1.8V/5V		HMP1E1

2011 TSMC CyberShuttle Service Plan

Shuttle Type (Technology)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
<b>40nm LP &amp; 45nm GS (45GS = 40G)</b>	Jan-5 TMEK01 Fab12 Kate	Feb-9 TMEK02 Fab14 Kate	Mar-2 TMEK03 Fab14 Kate	Apr-6 TMEK04 Fab12 FK	May-4 TMEK05 Fab14 FK	Jun-1 TMEK06 Fab14 FK
Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V)	V	V	V	V	V	V
Logic, 45GS (45GS = 40G) (0.9/1.8V, 0.9/2.5V)	V	V	V	V	V	V
<b>55 nm</b>	Jan-12 TMEK41 Fab14 Howard	Feb-16 TMEK42 Fab14 Howard	Mar-9 TMEK43 Fab14 Howard	Apr-13 TMEK44 Fab14 Kevin	May-11 TMEK45 Fab14 Kevin	Jun-8 TMEK46 Fab14 Kevin
Logic, G Plus (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, LP (1.2/1.8V, 1.2/2.5V, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, LP(1.2/1.8V, 1.2/ 2.5V, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
<b>65 nm (Part 1)</b>	Jan-12 TMEK61 Fab14 Kevin	Feb-16 TMEK62 Fab14 Kevin	Mar-9 TMEK63 Fab14 Kevin	Apr-13 TMEK64 Fab14 Howard	May-11 TMEK65 Fab14 Howard	Jun-8 TMEK66 Fab14 Howard
Logic, LP/DGO (1.2/2.5V,1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, G Plus/DGO (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, LP-based TGO (1.0/1.2/2.5V)	V	V	V	V	V	V
Logic, ULP (1.0/2.5V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, GP(1.0/ 2.5V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, LP(1.2/ 2.5V)	V	V	V	V	V	V
<b>65 nm (Part 2)</b>	Jan-24 TMEK81 Fab14 ZR		Mar-23 TMEK83 Fab12 ZR	Apr-27 TMEK84 Fab14 ZR	May-25 TMEK85 Fab12 ZR	Jun-22 TMEK86 Fab12 ZR
Logic, LP/DGO (1.2/2.5V,1.2/3.3V)	V		V	V	V	V
Logic, G Plus/DGO (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V)	V		V	V	V	V
Logic, LP-based TGO (1.0/1.2/2.5V)	V		V	V	V	V
Logic, ULP (1.0/2.5V)	V		V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, GP(1.0/ 2.5V)	V		V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, LP(1.2/ 2.5V)	V		V	V	V	V
<b>80 nm</b>					May-4 TMEJ98 Fab12 CH	
Logic, GC (1.0/2.5V, 1.0/3.3V)					V	
Logic, High Performance (1.2/1.8V, 1.2/2.5V)					V	
Mixed-Signal, GC (1.0/2.5V, 1.0/3.3V)					V	
<b>85 nm</b>	Jan-19 TMEL81 Fab12 CH	Feb-16 TMEL82 Fab12 CH	Mar-16 TMEL83 Fab14 CH	Apr-20 TMEL84 Fab12 CH	May-18 TMEL85 Fab14 CH	Jun-15 TMEL86 Fab12 CH
Logic, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF,G(1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, LP (1.2/2.5, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V

Shuttle Type (Technology)	Tape-In Date / TM # / Fab / Captain / Technology Availability					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
<b>90 nm</b>	Jan-19 TMEL01 Fab12 Jerry	Feb-16 TMEL02 Fab12 Jerry	Mar-16 TMEL03 Fab14 Jerry	Apr-20 TMEL04 Fab12 Jerry	May-18 TMEL05 Fab14 Jerry	Jun-15 TMEL06 Fab12 Jerry
Logic, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, GT (High Performance) (1.2/2.5V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V)	V	V	V	V	V	V
<b>0.11 um</b>	Jan-5 TMEL13 Fab6 Jerry			Apr-6 TMEL14 Fab6 Jerry		
Logic, G (1.2/3.3V), FSG	V			V		
Mixed-Signal, G (1.2/3.3V), FSG	V			V		
<b>0.12 um</b>		Feb-23 TMEL17 Fab14 CH				
Logic, G (1.2/3.3V), FSG		V				
<b>0.13 um</b>	Jan-19 TMEL21 Fab6 Frank	Feb-23 TMEL22 Fab14 Frank	Mar-16 TMEL23 Fab12 Frank	Apr-20 TMEL24 Fab6 Frank	May-18 TMEL25 Fab12 Frank	Jun-15 TMEL26 Fab12 Frank
Logic, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG	V	V	V	V	V	V
Logic, LP (1.5/2.5V,1.5/3.3V); FSG	V	V	V	V	V	V
Logic, LV (1.0/2.5V,1.0/3.3V); FSG	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG	V	V	V	V	V	V
<b>0.152um</b>		Feb-9 TMEK13 SSMC Frank		Apr-13 TMEK14 Fab10 Frank		Jun-8 TMEK15 SSMC Frank
Logic, G (1.8/3.3V)		V		V		V
Logic, LP (1.8/3.3V)		V		V		V
Mixed-Signal, G (1.8/3.3V)		V				V
<b>0.15/0.16 um</b>	Jan-12 TMEK33 Fab10 Frank		Mar-9 TMEK34 SSMC Frank		May-11 TMEK35 Fab10 Frank	

Shuttle Type (Technology)	Tape-In Date / TM # / Fab / Captain / Technology Availability					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
<b>0.18 um: Part 2</b>	Jan-24 TMEL61 Fab8 Kevin	Feb-23 TMEL62 Fab3 FK	Mar-23 TMEL63 Fab5 Francis	Apr-27 TMEL64 Fab8 Kevin	May-25 TMEL65 Fab3 FK	Jun-22 TMEL66 Fab5 Francis
Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP	V	V		V	V	
Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass only)	V	V		V	V	
Mixed-signal, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory)	V	V		V	V	
Mixed Signal, G, (1.8/5V)	V		V	V		V
Logic, G (1.8/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP	V	V		V	V	
Logic, LV (1.5/3.3V)	V	V	V	V	V	V
Logic, LP (1.8/3.3V)	V		V	V		V
EmbFlash(1K, 20K) (1.8/3.3V)		V			V	
EmbFlash Enhanced (1.8/3.3V)		V			V	
EmbFlash Enhanced (1.8/5V)		V			V	
EmbFlash HDR (1.8/3.3V)		V			V	
High Voltage (1.8/5/32V)	V		V	V		V
High Voltage (1.8/5/32V), Embedded OTP	V			V		
High Voltage (1.8/3.3/32V)	V			V		
High Voltage (1.8/3.3/32V), Embedded OTP	V			V		
High Voltage (1.8/5/18/24/32/40V), BCD	V			V		
<b>0.18 um: Part 3</b>		Feb-23 TMEL53 Fab10 Kate	Mar-16 TMEL54 Fab6 ZR		May-18 TMEL55 Fab10 Kate	Jun-15 TMEL56 Fab6 ZR
Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V)		V	V		V	V
Logic, G (1.8/3.3V)		V	V		V	V
Logic, LV (1.5/3.3V)			V			V
Logic, LP (1.8/3.3V, 1.8/5V)			V			V
<b>0.25 um: Part 1</b>	Jan-5 TMEK53 Fab10 Shirley		Mar-2 TMEK54 Fab3 Shirley		May-4 TMEK55 Fab11 Shirley	
Logic, G (2.5/3.3V, 2.5/5V)	V		V		V	
Logic, G (2.5/3.3V, 2.5/5V), Embedded OTP			V			
Logic, G (2.5/3.3V), Embedded MTP			V			
Mixed-Signal/RF, G (2.5/3.3V, 2.5/5V)	V		V		V	
Mixed-Signal, G (2.5/3.3V, 2.5/5V), Embedded OTP			V			
Mixed-Signal/RF, G (2.5/3.3V), Embedded MTP			V			
<b>0.25 um: Part 2</b>	Jan-19 TMEM01 Fab8 Kate	Feb-16 TMEM02 Fab8 Kate	Mar-16 TMEM03 Fab8 Kate	Apr-20 TMEM04 Fab8 Kate	May-18 TMEM05 Fab8 Kate	Jun-15 TMEM06 Fab8 Kate
Logic, G (2.5/3.3V, 2.5/5V)	V	V	V	V	V	V
Mixed-Signal/RF, G (2.5/3.3V, 2.5/5V)	V	V	V	V	V	V
High Voltage, BCD (2.5/5/12/40V)	V	V	V	V	V	V
High Voltage, BCD (2.5/5/12/40V), Embedded OTP	V	V	V	V	V	V
High Voltage, BCD (2.5/5/24/40V, 2.5/5/60V)	V	V	V	V	V	V
High Voltage, BCD (2.5/5/24/40V, 2.5/5/60V),Embedded OTP	V	V	V	V	V	V
<b>0.22 um/0.25 um: Part 3</b>		Feb-9 TMEK73 Fab11 Hedlard		Apr-6 TMEK74 Fab10 Hedlard		Jun-1 TMEK75 Fab11 Hedlard
0.25 um EmbFlash (2.5/3.3V, 2.5/5V)		V		V		V
0.22 um EmbFlash, Smart Card (2.5/3.3V, 2.5/5V)				V		

Shuttle Type (Technology)	Tape-In Date / TM # / Fab / Captain / Technology Availability					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
0.35 um: Part 1	Jan-5 TMEK93 Fab3 Kate		Mar-2 TMEK94 Fab10 Kate		May-4 TMEK95 Fab3 Kate	
Logic, G, Polycide/Silicide (3.3/5V)	V		V		V	
Mixed-Signal, G (3.3/5V)	V		V		V	
High Voltage, DDD (3.3/12/13.5/18V)	V				V	
High Voltage, DDD (3.3/12/13.5/15/18V)			V			
High Voltage, BCD (3.3/5/12/15/20/40V)	V				V	
High Voltage, BCD (3.3/5/12/15/20/40V), Embedded OTP	V				V	
High Voltage, BCD (3.3/20/23/Vg3.3V), Embedded OTP	V				V	
0.35 um: Part 2		Feb-16 TMEK19 Fab3 ZR			May-18 TMEK20 Fab3 ZR	
SiGe BICMOS, G (3.3V)		V			V	
0.5 um HV 800V			Mar-30 TMEK59 Fab3 Jerry V			Jun-29 TMEK60 Fab3 Jerry V

Tel: +886-3-5636688 Ext.

If you have any CyberShuttle questions,  
please email [cybershuttle@tsmc.com](mailto:cybershuttle@tsmc.com)  
or contact captains directly.

David	David Chen	<a href="mailto:cwchenc@tsmc.com">cwchenc@tsmc.com</a>	702-3629
Frank	Frank Lu	<a href="mailto:gflu@tsmc.com">gflu@tsmc.com</a>	702-3628
FK	Feng-Kai Chen	<a href="mailto:fkchen@tsmc.com">fkchen@tsmc.com</a>	702-3104
CH	Chih-Hsing Chen	<a href="mailto:chcheng@tsmc.com">chcheng@tsmc.com</a>	702-3664
Kate	Kate Liu	<a href="mailto:cflue@tsmc.com">cflue@tsmc.com</a>	702-3650
Hediard	Hediard Chang	<a href="mailto:hichang@tsmc.com">hichang@tsmc.com</a>	702-3610
Shirley	Shirley Kuo	<a href="mailto:hikuob@tsmc.com">hikuob@tsmc.com</a>	702-3619
Howard	C.H. Hung	<a href="mailto:chhungg@tsmc.com">chhungg@tsmc.com</a>	702-3103
Kevin	Kevin Liu	<a href="mailto:kwliu@tsmc.com">kwliu@tsmc.com</a>	702-3618
ZR	Zi-Ran Huang	<a href="mailto:zrhuang@tsmc.com">zrhuang@tsmc.com</a>	702-2199
Jerry	H.J. Huang	<a href="mailto:hjhuangk@tsmc.com">hjhuangk@tsmc.com</a>	702-3103
Francis	Francis Tsai	<a href="mailto:YYTSAIA@tsmc.com">YYTSAIA@tsmc.com</a>	702-3627

咨询：西安集成电路设计专业孵化器有限公司

联系人：

郭宝华 029-88328230-8021 E-mail:[guobh@xaic.com.cn](mailto:guobh@xaic.com.cn)

倪明刚 029-88328230-8028 E-mail:[nimg@xaic.com.cn](mailto:nimg@xaic.com.cn)

## 西安市科学技术局

### 关于申报 2011 年西安市科技计划项目的通知

各有关单位：

2011 年西安市科技计划重点围绕统筹科技资源改革和创新型城市建设目标任务，组织开展科技创新活动。2011 年科技计划由创新支撑、发展引导和环境建设三大主题计划及高新技术产业发展专项构成。主题计划由 6 类计划 15 个项目类别组成；高新技术产业发展专项含 2 类计划 5 个项目类别，由市高新技术产业发展领导小组办公室另行发布。

1. 申报时间：2011 年面向社会公开征集的科技计划项目实行分批次、分类别组织申报。

第一批计划项目（2010 年 12 月 10 日—2011 年 1 月 21 日，共 6 个项目类别）：企业技术创新项目、科技成果转化项目、农业科技创新项目、社会发展科技应用示范项目、医疗卫生应用研究项目、软科学研究项目。

第二批计划项目（共 3 个项目类别）：中小企业技术创新基金项目、工业技术应用研发项目、区县工业科技引导项目。

第三批计划项目（共 3 个项目类别）：青年科技人才创业项目、半导体照明（LED）示范工程项目、创新型企业试点项目。

知识产权管理环境建设项目、科技资源大市场建设项目和科技公共服务体系建设项目等 3 个类别项目，由市科技局组织安排实施。

2. 申报地点：大南门外振兴路 137 号，市科技局办公楼 111 室。

第二、三批计划项目申报时间暂定为 2011 年第二、三季度初，具体时间、地点，及项目申报要求、程序，请登陆“西安科技网”（<http://www.xainfo.gov.cn>）查询。

指南咨询：西安市科技局计划财务处 西安市科技项目信息管理中心

联系人：王 斌 赵小尊 刘 敏

88402959 88412996 88405549

### 国家集成电路设计西安产业化基地

国家集成电路设计西安产业化基地设立于 2000 年 11 月，是继上海之后全国第二个国家级集成电路设计产业化基地，是全国七个集成电路设计产业化基地之一，位于西安高新区内。

旨在聚集优势资源，营造良好的产业环境，提升人才、技术、企业的聚集能力，发展集成电路产业集群，培育区域高新技术产业的新增长点。

基地以 EDA 设计与服务平台、测试分析平台、培训平台、MPW&IP 平台和信息平台为依托，构成专业技术支撑体系，以技术转移平台、招商与咨询平台、项目与合作交流平台为依托，构成咨询服务体系。

### 西安市集成电路产业发展中心

**XAIC** 是市科技局直属事业单位，接受其它相关政府业务主管部门的行业指导和业务委托，旨在“组织、协调、引导、推进”西安集成电路产业的发展，并承担国家集成电路西安产业化基地的建设、管理与服务工作。

宗旨：整合优势资源，构筑支撑平台，培育创新源头。

使命：创造优良环境，完善服务体系，提供一流服务。

目标：成为本地集成电路产业服务与合作的平台。

### 西安集成电路设计专业孵化器有限公司

**XAICC** 设立于 2000 年 11 月，专业从事集成电路设计企业的孵化与成长服务，引进海外留学生回国创业，“孵小、育中、扶强”，培育创新型集成电路设计企业。

宗旨：营造专业环境，构筑创新创业平台。

使命：健全服务体系，孵化一流创新企业。

目标：成为本地集成电路设计企业孵化的摇篮、成长的供给站、聚集的平台。

### 陕西省半导体行业协会

本协会是由陕西地区从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备、半导体照明、光伏电池的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其他相关的企、事业单位自愿结成的全省性、行业性、非盈利性的社会组织，具有独立法人资格。

协会宗旨：会员服务，为行业服务，为政府服务；在政府和会员单位之间发挥桥梁和纽带作用；维护会员单位和本行业的合法权益，促进半导体行业的发展。

---

## 《陕西省半导体行业》简讯（季刊）

---

地 址：陕西省西安市高新六路腾飞创新中心 A-2-9

电 话：029-88328230

邮 编：710075

传 真：029-88316024

E-mail: [gaobo@xaic.com.cn](mailto:gaobo@xaic.com.cn)

联 系 人：高博 严越

联系电话：029-88328230-8010

029-88328230-8006